

**Dr.inż.Włodzimierz Strupiński**, prekursor technologii MOCVD w kraju, jest kierownikiem zakładu epitaksji związków półprzewodnikowych w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) w Warszawie. Z ITME jest związany od 1980 r., gdzie zajmuje się technologią epitaksji z fazy gazowej CVD oraz MOCVD półprzewodnikowych materiałów typu III-V (pochodne GaAs, InP, GaN, GaSb) oraz SiC i grafenu. Jego badawcze zainteresowania obejmują wytwarzanie struktur epitaksjalnych stosowanych w mikro- i opto-elektronice (tranzystory, diody mikrofalowe, waraktory, lasery, fotodetektory, falowody, diody LED, kropki kwantowe, itp.). Opracowane technologie wytwarzania epi-struktur wykorzystywane są w pracach badawczych, we współpracy z wieloma instytucjami naukowymi w kraju i na świecie oraz dla celów komercyjnych.